

- Михайлов Н.Н., Швец В.А., Икусов Д.Г., Ужаков И.Н., Дворецкий С.А.*
- 2.13 Эллипсометрический контроль параметров квантовых ям при выращивании лазерных структур на основе $\text{HgTe/Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$
-
- Дементьев П.А., Давыдов В.Ю., Лебедев М.В., Львова Т.В., Смирнов А.Н.*
- 2.14 Электронные свойства интерфейса $\text{In}_2\text{S}_3/\text{InN}$
-
- Емельянов Е.А., Путьато М.А., Петрушков М.О., Васев А.В., Лошкарёв И.Д., Семягин Б.Р., Преображенский В.В.*
- 2.15 МЛЭ твёрдых растворов $\text{InAs}_x\text{Sb}_{1-x}$ на вицинальных подложках $\text{GaAs}(001)$ с использованием потоков молекул As_2 и As_4
-
- Журавлев А.Г., Романов А.С., Савченко М.Л., Казанцев Д.М., Альперович В.Л.*
- 2.16 Влияние ширины приповерхностной области изгиба зон на вероятность выхода электронов из Cs/GaAs
-
- Иванова Е.В., Дементьев П.А., Ситникова А.А., Александров О.В., Загорянская М.В.*
- 2.18 Формирование нанокompозитного слоя в диоксиде кремния и его электрофизические свойства
-
- Илькив И.В., Котляр К.П., Амелчук Д.Г., Лебедев С.П., Буравлев А.Д.*
- 2.19 Формирование композитных плёнок оксида кремния с включениями коллоидных наночастиц золота
-
- Казанцев Д.М., Ахундов И.О., Кожухов А.С., Альперович В.Л., Латышев А.В.*
- 2.20 Кинетическое огрубление рельефа поверхности GaAs : эксперимент и Монте-Карло моделирование
-
- Кацюба А.В., Кучинская П.А., Крупин А.Ю.*
- 2.21 Модифицирование поверхности CaF_2 сфокусированным электронным пучком
-
- Кацюба А.В., Рудин С.А., Кучинская П.А., Крупин А.Ю.*
- 2.22 Расчет изменения температуры многослойных гетероструктур в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии
-
- Колосов В.Ю.*
- 2.23 Формирование необычных трансротационных кристаллов, выявляемых дифракционной электронной микроскопией *in situ* при фазовых переходах в тонких аморфных плёнках